

Спосіб виготовлення омичного контакту метал-напівпровідник до перовськіту CsPbBr_3 , що включає механічне та хімічне полірування підкладинок CsPbBr_3 та нанесення металу, який **відрізняється** тим, що поверхню підкладинки перед нанесенням металу обробляють не менше 20 хвилин в аргонівій плазмі при напрузі не менше 500 В та при температурі не менше 100 °С.